



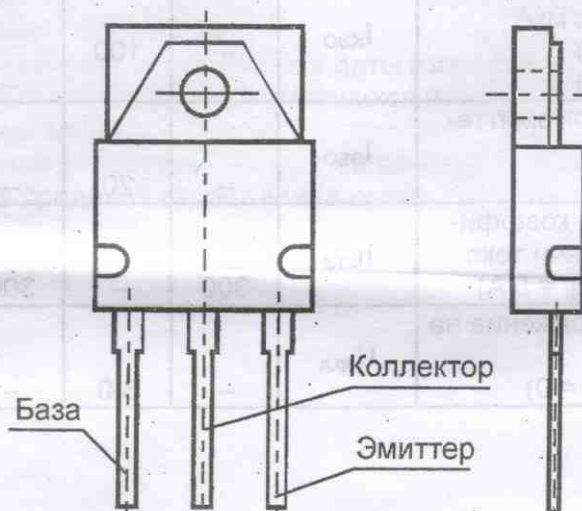
Транзисторы типов  
КТ8232А1, КТ8232Б1

Коды ОКП  
КТ8232А1 — 6341268571  
КТ8232Б1 — 6341268581

ЭТИКЕТКА

КФДЛ.432147.022

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n составные мощные высоковольтные транзисторы типов КТ8232А1, КТ8232Б1 в пластмассовом корпусе с встроенной схемой ограничения напряжения коллектор-эмиттер и с внутренним диодом для защиты от пробоя при перемене полярности источника питания, предназначенные для работы в импульсных схемах вторичных источников питания на индуктивную нагрузку.



Масса не более 5,5 г

# 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при  $t_{кор} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		КТ8232А1		КТ8232Б1	
		не менее	не более	не менее	не более
Граничное напряжение, В ( $I_K = 100 \text{ mA}$ )	$U_{K30гр}$	350	—	300	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_K = 8 \text{ A}, I_B = 100 \text{ mA}$ ) ( $I_K = 10 \text{ A}, I_B = 250 \text{ mA}$ )	$U_{K3нас}$	—	1,8	—	1,8
		—	1,8	—	1,8
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_K = 8 \text{ A}, I_B = 100 \text{ mA}$ ) ( $I_K = 10 \text{ A}, I_B = 250 \text{ mA}$ )	$U_{B3нас}$	—	2,2	—	2,2
		—	2,5	—	2,5
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ( $U_{K3} = 300 \text{ В}$ ) ( $U_{K3} = 250 \text{ В}$ )	$I_{K30}$	—	100	—	100
Обратный ток эмиттера, мА ( $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$ )	$I_{ЭБ0}$	—	20	—	20
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{K3} = 10 \text{ В}; I_K = 5 \text{ A}$ )	$h_{21э}$	300	—	300	—
Прямое напряжение на диоде, В ( $I_Э = 10 \text{ A}, I_B = 0$ )	$U_{пр.д}$	—	3,0	—	3,0

1.2 Драгоценных металлов не содержится.

1.3 Содержание цветных металлов в одной транзисторе:

медь — **3,4** г в корпусе.

## 2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Интенсивность отказов  $\lambda_3$  в течение наработки ( $t_n$ ) не более  $10^{-6}/\text{ч}$ . Нарботка транзисторов  $t_n = 25\ 000 \text{ ч}$ .

2.2 98-процентный срок сохраняемости транзисторов — 10 лет.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества каждого транзистора требованиям АДБК.432140.837ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных ГОСТ 11630-84 и АДБК.432140.837ТУ.

Гарантийный срок — 10 лет.

Гарантийный срок исчисляется с даты изготовления транзисторов, а для транзисторов, подвергавшихся перепроверке, — с даты их перепроверки.

Гарантийная наработка — 25 000 ч в режимах и условиях, допускаемых ТУ в пределах гарантийного срока.

#### 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ8232А1, КТ8232Б1 соответствуют техниче-  
ским условиям АДБК.432140.837ТУ и признаны годными для экс-  
плуатации.

Приняты по извещению № 76 от 24 ИЮН 2013  
УПАКОВЩИК № 4 дата

ОТК772

Штамп СКК

Пере проверка произведена \_\_\_\_\_  
дата

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
дата

Штамп СКК